

(19)  
(12)

(KR)  
(A)

(51) 。 Int. Cl.<sup>7</sup>  
G02F 1/1343

(11)  
(43)

10-2004-0087990  
2004 10 15

(21) 10-2004-0074373 ( )

(22) 2004 09 17

(62) 10-2001-0062908

: 2001 10 12

2001 11 30

(30) JP-P-2000-00312971 2000 10 13

(JP)

JP-P-2001-00198800 2001 06 29

(JP)

(71) 가 가

4 14 12

(72) 가 가

4 14 12

4 14 12 가 가

4 14 12 가 가

4 14 12 가 가

(74)  
:

(54) ,

(14) (2) , (12) , (12) (16)

1(a) 1

1(b) 1

2(a) 가

2(b)

2(c)

3(a) (c) 1 (

1).

4(a) (c) 1 (

2).

5(a) 3(c) D

5(b) 5(a) I - I

6 1

7 2

[ ]

2 :

4 :

6 : 1

6a : 2

8,8a :

10 :

10a :

10b :

10c :

10d :

12a :

12b,32b : AI ( )

12,32 :

14,14a :

16,16a,16b,16c : ( )

17 :

18,18a :

19 :

20,20b :

20a,20c :

22 :

24 :

26 :

28 :

30,30a :

32a :

34a :

36 : ( )

38 :

40 :

42 :

44 :

46 :

( )

가

2 가 2 , 2

가

가

가 가

가

가

가 3 1

가 가 가

( )

( 4 - 267220 ), 2 ( 12 - 193807 ) ( 12 - 171792 )

가

가 가

(damage) 가 가

가

가 .

ITO , ITO 가 .

가 .

( ) 가 .

가 .

(moire) 가 .

가 .

4 - 267220  
12 - 193807  
12 - 171792

2 가 가 .

가 50 200 $\mu$ m

가 가 가 .

가 가 가 .

가 .

가 가 가 .

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

10 20% )

(

)

(

가

,가

가

가

가

,가

가

가  
가

가

가

가

( )

가

(貧)

가

가

< >

( 1 )

( )

1(a)

1(b)

1

1

( 1 )

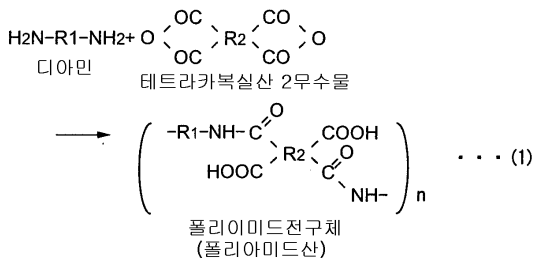
1

3,3'-

(1)

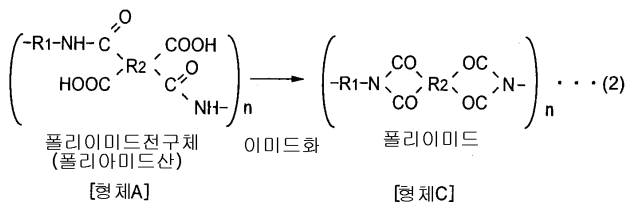
( 18%)

[ 1 ]



(2) 300g 150 60 가 ( )

[ 2 ]

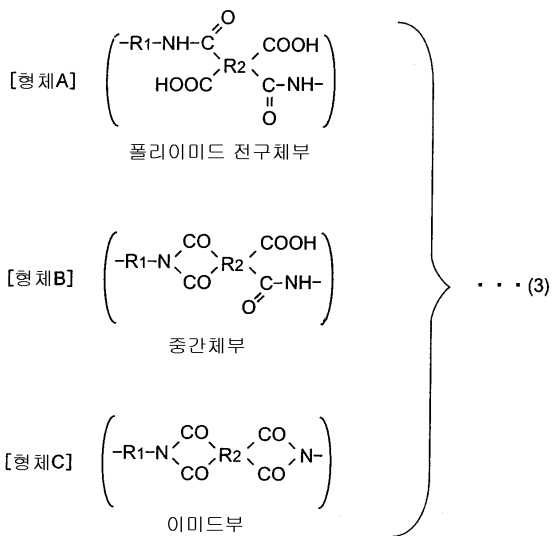


B (2) C가 (3) 가 (2) A( )

가 (3) A( )

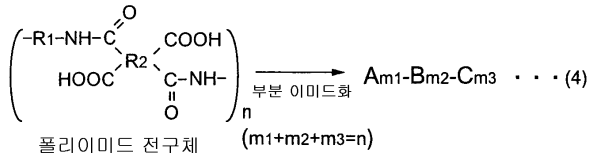
B( ) C( ) 가 (3) A( )

[ 3 ]



가 (4)

[ 4 ]



가 , 45 50% 가 , 30 90% 가 , 2

가 , 가 , 100g ( ) 가

가

100 , 30 100 ,

34) 1(a) 1000rpm 12 (36) (風乾) (34) (34) (34a)가 (34) (34) (34a)가 (34)

(32a) 1(b) , 200 (34) (32a) (32a)

( ) 가 0.5 10 $\mu$ m, ( ) 2 $\mu$ m , 0.2 0.4 $\mu$ m 5 6 $\mu$ m

32) 1(b) (32a) , 30 가 50 100nm Al( ) (32a) Al (32b) (32a)

, Al , Ti( ), Ag( ), Pt( ), Ta( ), Pd( )

1 가 (32a) 가

가 가

( 2 )

2 1 1 1

2 , , 1 ( 18%)

( )

120 170 가 , 2

가

, NMP(N- ), DMF( ) DMAc( ) , ,

1 (34) (34)

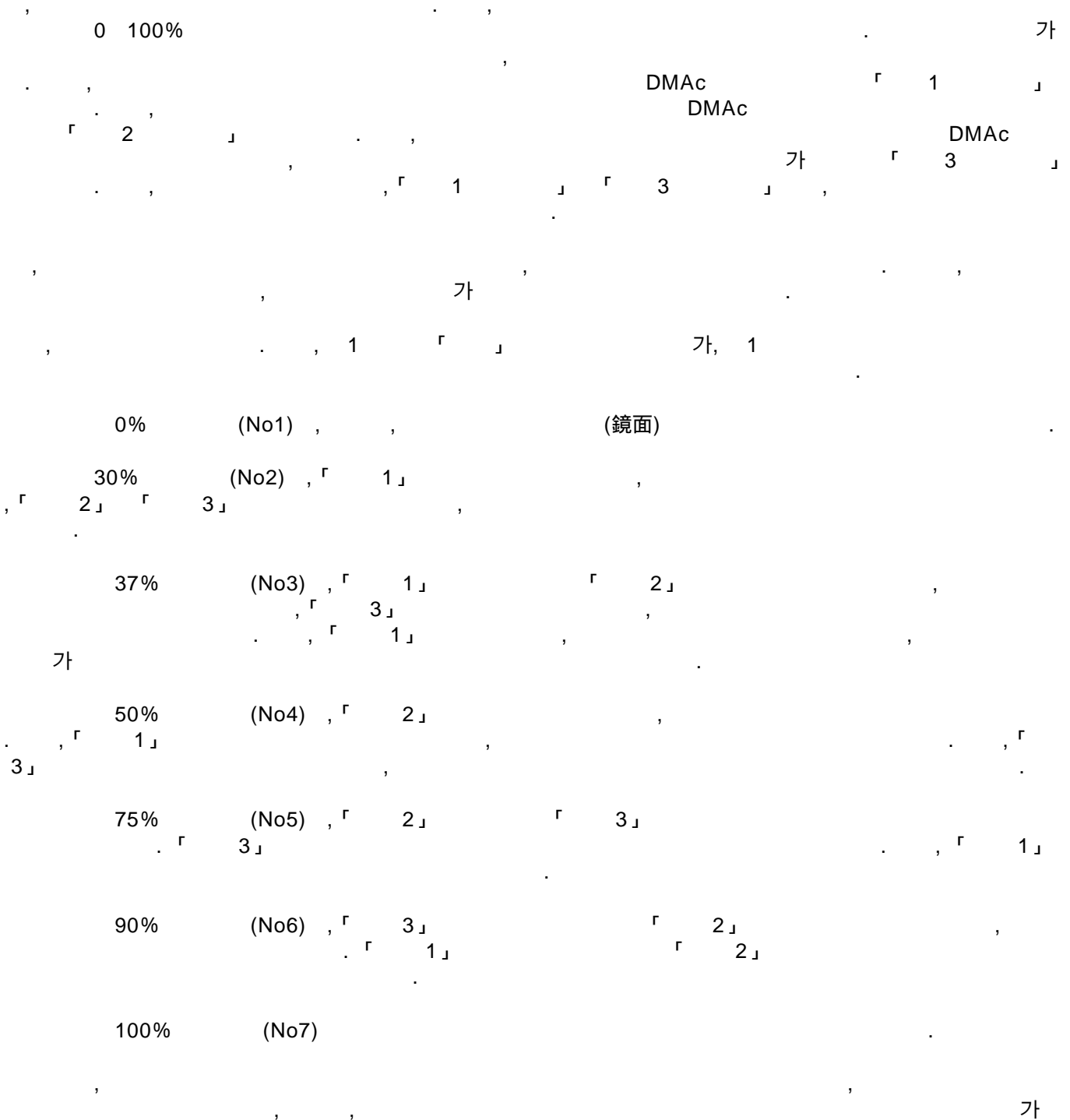
1(a) (34)

0 90% , (34) 3

1

[ 1 ]

No.	온도 (°C)	시간 (분)	이미드화율 (%)	도공막의 표면상태		
				조성1의 도포액 (중간고형물 + DMAc)	조성2의 도포액 (중간고형물 + DMAc + 시클로헥산)	조성3의 도포액 (중간고형물 + DMAc + 시클로헥산+전구체)
1	—	—	0	부적합 (경면)		
2	130	60	30	적합 ← 부적합 (반경면~경면)		
3	140	60	37	부적합 (얼룩) ← 적합 → 부적합 (반경면~경면)		
4	150	60	50	부적합 (얼룩 영역) ← 적합 → 부적합 (반경면~경면)		
5	160	40	75	부적합 (얼룩 영역) ← 적합 → 부적합 (반경면~경면)		
6	170	30	90	부적합 (얼룩 영역) ← 적합 →		
7	260	30	100	부적합 ( 용해하지 않음 )		



100% 가

2, 30% 90% 1 3 37 75% (34) 30 90%

2

(34) 1 (32a)

1 (32a) Al (32b) (32a) (32) Al (32b)

2 1

( 3 )

3 1 2

3 500g 180g (JSR : SS6917)

115 5 가

250g 90g

1200rpm 가

1 2

220 가 1(b) (32a)

1 Al Al

3 1

( 4 )

4 가 2

4 2 1

3,3 ' -

28% 1 3,3 ' -

28% 2

2 가 100 : 100 가 360

가

1000rpm 30 , 가 , 0.5 5 $\mu$ m , 1600 2000rpm 30 600

30 , 2 , 가 2

200 , 60 , 가 1(b) (32a)

1 ( ) ( ) 0.1 2 $\mu$ m

2 20 $\mu$ m

1 , 가 50 100nm Al , 30

Al 가

1 Al

1 4 ( )

( 1 2 )

2(a) 가 2(b)

2(c)

가 1 2

1 2 2(a) (42)

(32a) (32b) (42) (32a) (32)

(38) 가 (32b) (38)

(42) (32) (32a) (32b) (38)

(46) (32) (42) (44) 2(b) (38) (46) (38)

가 (46) (46)

7.4 35.6 (46) (32)

(44)

(32) 100 (32) 100

100

(32) 가

2(c) 가 7.4 , 17.7 , 22.3  
2.2 4.4 가

(32) 가 (32)

(32) 가 가

2(a) (38) (32b) 가

(32)

(La) , (Lb) , La  
/ Lb ( ) 가 La / Lb .  
( )

3(a) (c) 1 ( 2) .  
1), 4(a) (c)

1 가 0.7 1.1mm (2) 3(a) (2) .

(2) 가 4μm (4)

3(b) (4) 가 0.1 0.4μm ITO(Indium tin oxide) 1  
(6) , ITO

(4) 1 (6) 가 , 가 2 5μm (8)

3(c) (8) 1 (6) 1 (6)  
가 (10d) .

(10d) (8) (10d) 가 (10d) (10a)

(10b)





, (28) (20a) (24) , (26) , (26)

, 6 1 (30)가 .

1 (20,20a) (3)

0) (16) (24) (12)가 (12) (20a)

(16) (24) , (24) . , (26) (28) .

, (16) , 1 가 3

1 (12) (2a)

(12a) , (12a)

( 2 )

7 2 .

2 가 1 , 7

6 ,

, 7 (20b) . , 1

, 1 (8), (12) (14) , , 1 (6)

, (16b) , (16b) (6) (14) (18)

, (18) , (20b)

, 7 (20c)

, 1 (8a), (10) (14a) , , 2 (6a)

, (16c) 2 (14a) (16c)

, (6a) (18a) , (18a)

, (20c)

, 1 (20b) (20c) (22)

, (24)

, (20c) (24) , (26) (28)

, (20c) (10) (30a)가 .

, 1 2 ,

, 1 2 (2) (12) (14)

, (16) (14) , (12) (14) (16)

(2) (12)

1 2

(thinner)

1 10μ

2

1

2

가

가,

가

가

가

( )

(57)

1.

(界面)

2.

1

2 3.

1 4.

4 5.

4 6.

(前驅體) (單體), 2

4 7.

(Al), (Ti), (Ag), (Pt), (Ta) (Pd)

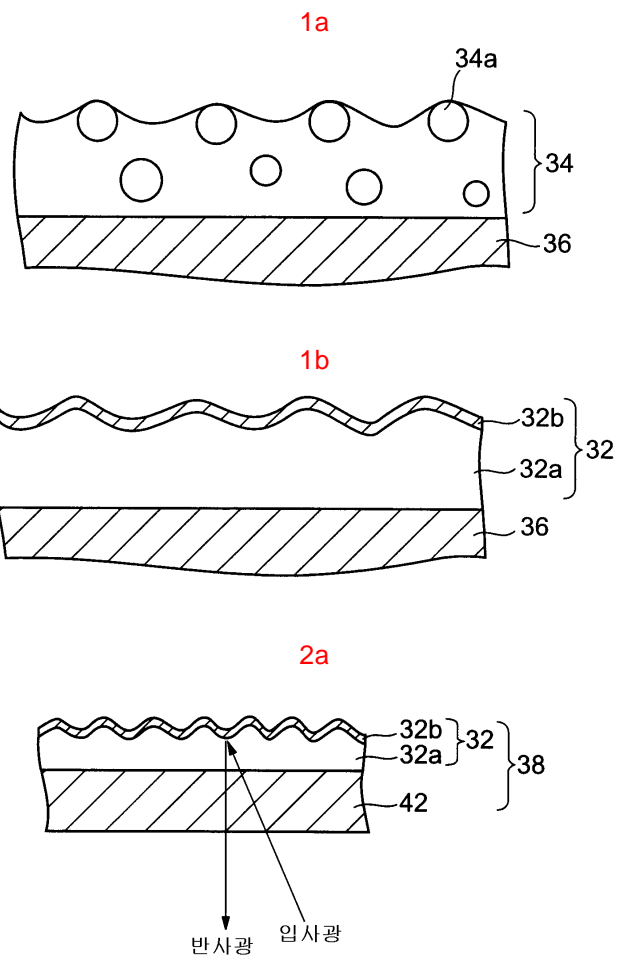
8.

1 9. 2 1 2

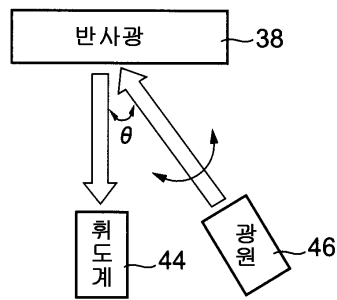
1

2

가,



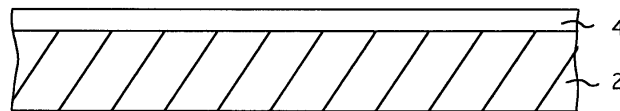
2b



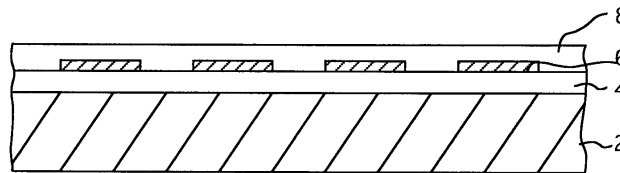
2c

	7.4°	17.7°	22.3°	26.6°	31.8°	35.6°
비교 시료	493	278	218	99	91	11
본 반사재	443	279	222	173	134	91

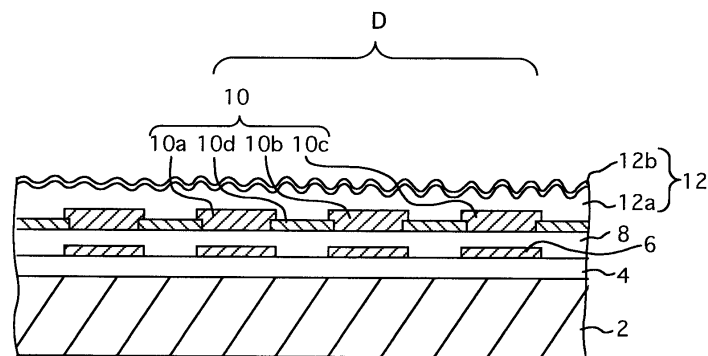
3a

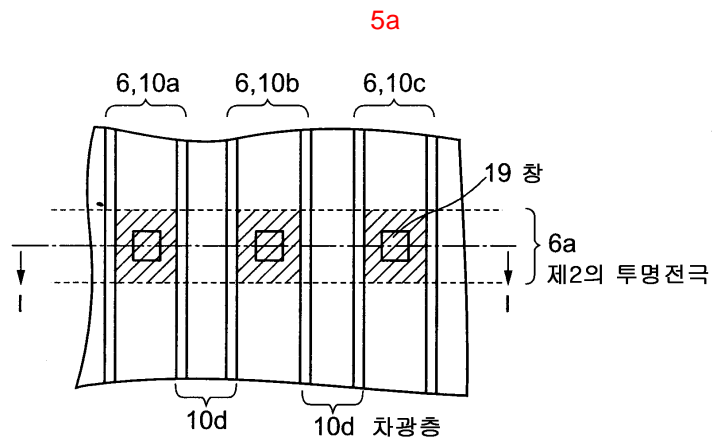
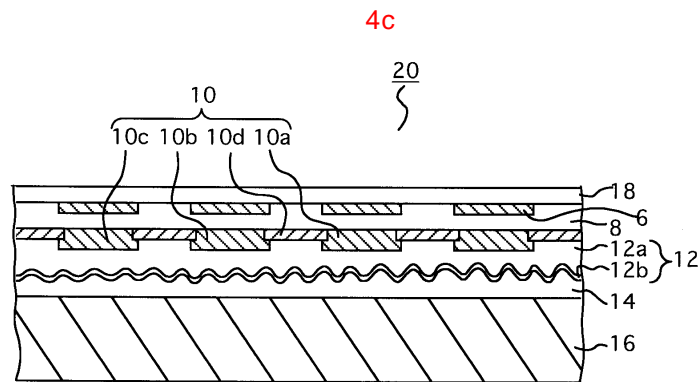
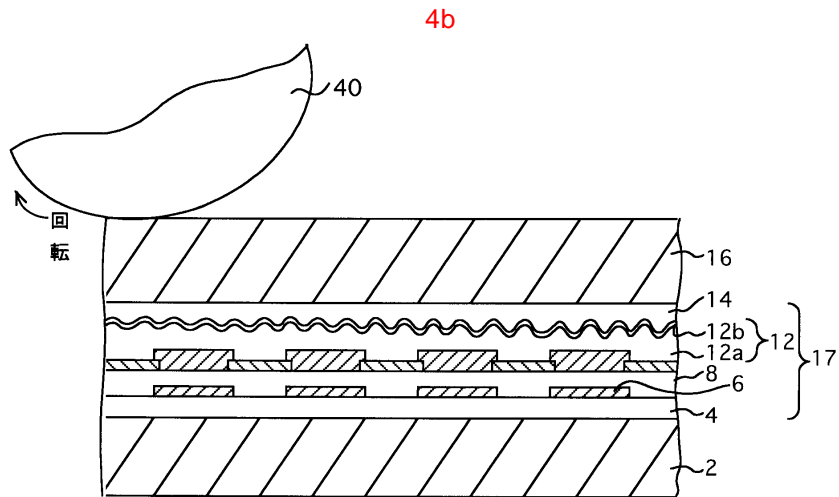
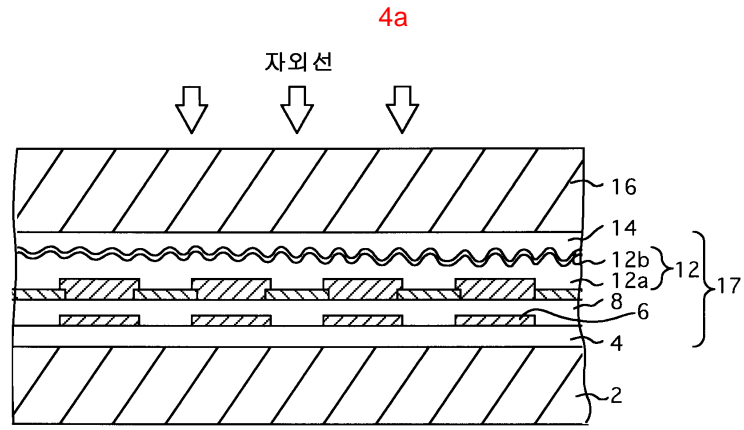


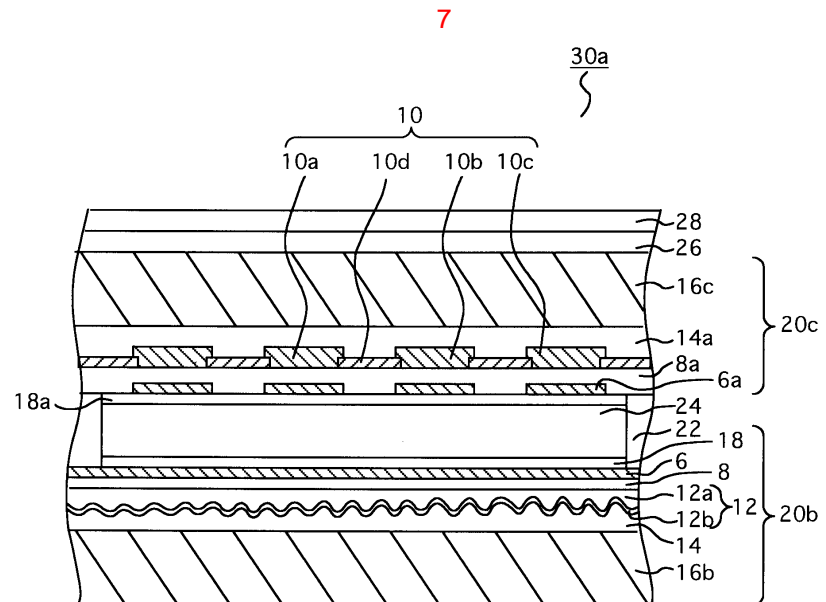
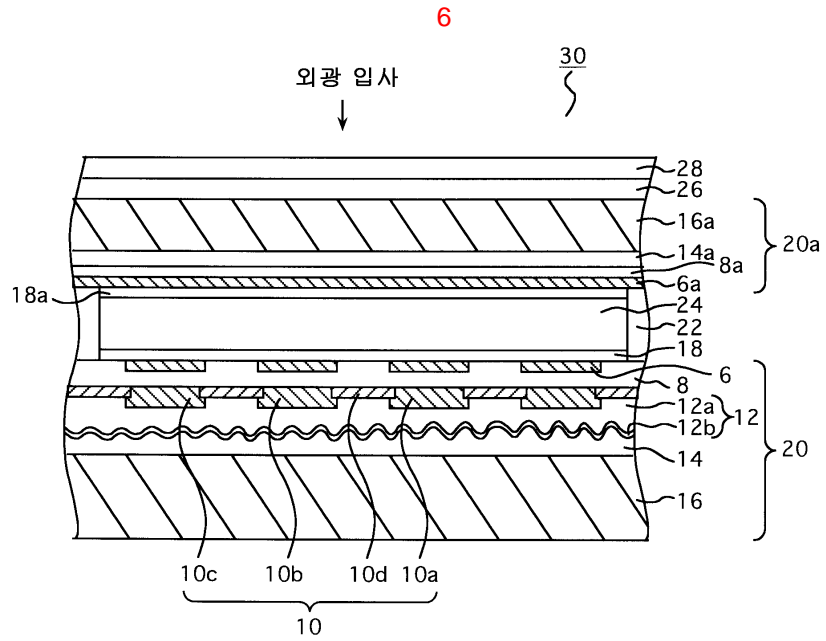
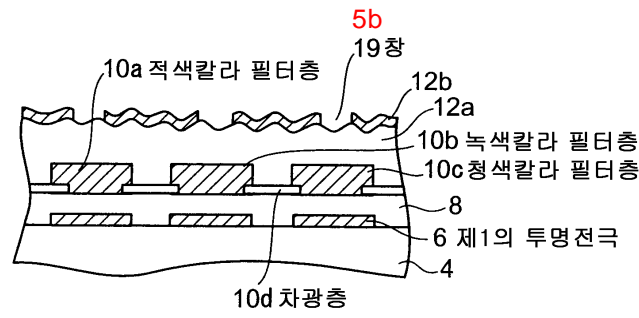
3b



3c







专利名称(译)	一种液晶显示装置的电极基板的制造方法，由此制造的液晶显示装置的电极基板，		
公开(公告)号	<a href="#">KR1020040087990A</a>	公开(公告)日	2004-10-15
申请号	KR1020040074373	申请日	2004-09-17
[标]申请(专利权)人(译)	共同社印刷有限公司		
申请(专利权)人(译)	无论惩教人员包装箱株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	无论惩教人员包装箱株式会社		
[标]发明人	FURUKAWA TADAHIRO 후루카와다다히로 OKAYASU KIMIKAZU 오카야스기미카즈 SATO HISASHI 사토히사시 MURAI TATSUHIKO 무라이다츠히코		
发明人	후루카와다다히로 오카야스기미카즈 사토히사시 무라이다츠히코		
IPC分类号	G02F1/1333 G02B5/08 G02B5/02 G02F1/1335 G02F1/1343		
CPC分类号	G02F1/134336 G02F1/133553		
代理人(译)	MOON, KI桑		
优先权	2000312971 2000-10-13 JP 2001198800 2001-06-29 JP		
其他公开文献	KR100501975B1		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

本发明的目的是提供一种液晶显示器的电极基板的制造方法，其限制不在于材料或制造条件，并且制造成本低，而且产量高。在本发明中，它具有转移工艺的过程，在基板(2)的上表面上形成具有凹凸的反射材料(12)和在膜(16)上的反射材料(12)。粘合层(14)。液晶显示器，液晶显示器的电极基板和反射材料。

